PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-177864

(43)Date of publication of application: 25.06.1992

(51)Int.CI.

H01L 23/12

H01L 23/14

H05K 3/46

(21)Application number : 02-304152

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

13.11.1990

(72)Inventor: ORITO NAONORI

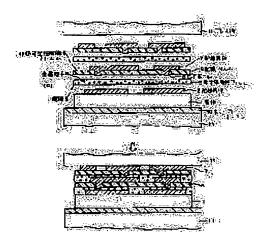
MATSUI KOJI

(54) MANUFACTURE OF MULTILAYER INTERCONNECTION SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a fine and high multilayer interconnection to be formed easily and positively by placing an anisotropic conductive film which consists of a resin indicating a thermoplastic property between layers of an insulation resin film whose wiring is formed and by performing heated contact bonding.

CONSTITUTION: An anisotropic conductive film 5 consisting of a polyimide resin containing fluorine 3 and a metal particle 4 is placed between wiring films 9 or between layers with a substrate 1 where the wiring films 9 and a wiring conductor 2 are formed, positioning is performed for lamination, and then a hot plate oven 10 is used for heating while applying pressure using a press machine 11, thus enabling non-thermoplastic resin films 6 to be adhered with the polyimide film containing fluorine 3 as an adhesion layer and obtaining electrical connection so that a metal particle 4 is pressed for wiring conductors 2 and 7 and a conduction via hole 8 for completing a multilayer interconnection substrate. Therefore, it is possible to form a multilayer interconnection substrate with improved pattern accuracy using an easy process.



⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-177864

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月25日

23/12 H 01 L H 05 K

N

23/14

R

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

図発明の名称

多層配線基板の製造方法

②特 願 平2-304152

願 平2(1990)11月13日 23出

@発 明 沯 下 盾 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

@発 明 松 叏 勿出 願 日本電気株式会社 人

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目7番1号

弁理士 舘野 千恵子 19代 理 人

1. 発明の名称

多層配線基板の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 配線用導体と耐熱性を有する絶縁樹脂膜から なる多層配線基板の形成において、配線形成さ れた絶縁樹脂膜の層間に熱可塑性を示す樹脂か らなる異方導電性フィルムを配置し、加熱圧着 することにより多層積層する工程を含むことを 特徴とする多層配線基板の製造方法。
- (2) 絶縁樹脂饃は、完全硬化した膜であり、かつ 熱可塑性を示さない樹脂からなることを特徴と する請求項(1) 記載の多屬配線基板の製造方 法。
- (3) 異方導電性フィルムの樹脂成分は、含フッ素 ポリイミドからなることを特徴とする請求項 (1) 記載の多層配線基板の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明
- [産業上の利用分野]

本発明は、集積度の高いLSI実装用の多層配 線基板に関し、特に数細かつ高多層配線ができ、 高密度実装が可能な多層配線基板の製造方法に関 するものである。

[従来の技術]

集積度の高いLSI実装用の多層配線基板には、 金属からなる配線用導体艦と、ポリイミドなどの 耐熱性を有する絶縁樹脂膜から構成されているも のが知られている。

従来、この種の多層配線基板の製造方法として は、配線形成されたポリイミドフィルムを一括積 層して加熱圧着する方法が知られている。

第2図は、従来技術による多層配線基板の製 造方法を工程順に示す工程図、第3図は第2図の (b) 工程における丸印で囲んだ部分の拡大断面図 である(特開昭63-274199号公報参照)。

第2図(a) に示すように、ポリイミド樹脂21中 に、銅配線22が形成されている配線フィルム23を 積層し、得られる多層フィルム2.4を第2図(b) に 示すように、荷重25により加圧し、高周波誘電加

特閒平4-177864 (2)

熱ヒータ26により加熱することにより、第3図に示すように、銅配線と銅配線同士は金属間の拡散接合27で、またポリイミド同士はイミド化反応による接合28で結合させ、多層配線フィルム29を形成する(第2図(c))。さらにこの多層配線フィルム29を第2図(d)に示すように、セラミック基板30に搭載し、はんだ31によりLSI32と接続し、多層配線基板を完成させる。

[発明が解決しようとする課題]

上述した従来の多層配線基板の製造方法における配線導体の電気的接続方法には、接着界面に金属拡散を促進する金属薄膜をコーティングし拡散接合させる方法が知られているが、配線導体の接着界面あるいは配線形成されたフィルム表面の平坦精度に問題があり、配線導体の電気的接続の信頼性に欠けるといった問題点があった。

また、従来の多層配線基板の製造方法としては、 イミド化がほとんど進行していないフィルムに配 線を形成し、この配線形成されたフィルムを一括 積層して加熱圧着する方法となっていた。このた・ め加熱圧智時にフィルムのイミド化が進行し、これに伴って発生する縮合水が原因で、積層界面ではがれ、ふくれ等を生じるという欠点がある。また、イミド化に伴い、フィルムの膜減り、収縮が起こり、パターン精度が悪くなるという欠点もあっ

さらにはフィルムに配線パターンを形成するにあたり、イミド化がほとんど進行していないポリイミドフィルムは、耐ウェットエッチ性、耐ドライエッチ性ともに欠けるという問題点があり、微細かつ高精度な配線パターンを形成することは極めて困難となる。

以上の点から、縮合水が発生せず、硬化時の膜 減り、収縮も起こらず、耐エッチング性に優れる 樹脂フィルムに配線パターンを形成することが望 ましい

本発明の目的は、上記問題点を解決し、微細かつ高多屬配線を容易かつ確実に形成することができ、高密度実装が可能な多層配線基板の製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、配線用導体と耐熱性を有する絶縁樹脂膜からなる多層配線基板の形成において、配線形成された絶縁樹脂膜の層間に熱可塑性を示す樹脂からなる異方導電性フィルムを配置し、加熱圧着することにより多層積圧する工程を含むことを特徴とする多層配線基板の製造方法である。

本発明において、絶縁樹脂膜は、完全硬化した 膜であり、かつ熱可塑性を示さない樹脂からなる ことを好適とし、また、異方導電性フィルムの樹 脂成分は、含フッ素ポリイミドからなることを好 適とする。

[作用]

世来技術による多層配線基板の製造方法によれば、イミド化がほとんど進行していない未硬化也脂フィルムに配線を形成し、これを一括積層して加熱圧着していたが、本発明によれば、例えばイミド化が 100%に進行した完全硬化樹脂フィルムをに配線を形成する。完全硬化した樹脂フィルムを用いているので、耐ウェットエッチ性および耐ド

ライエッチ性に優れ、また機械的強度、化学に優れ、また機械的強度、化学を関係を生む機械を生かる。特性を極める関連という。 をおいるでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、でいいのでは、でいいのでは、でいいのでは、でいいのでは、でいる。といいのでは、でいるには、でいいるには、でいいのでは、でいいるには、でいる。といいのでは、でいる。

特問平4-177864 (3)

定の間隔で規則正しく配列した構造となっており、 樹脂フィルム成分は完全硬化し、かつ熱可塑性を 示すものからなる。例えば、含フッ素ポリイミド を用いることができ、これはイミド化が 100%に 進行した完全硬化樹脂フィルムであり、軟化点は 280℃から 300℃である。

〔実施例〕

を用いて加圧(10 Kg/cm²) しながらホットプレートオープン10で加熱(300℃. 30 分)する。その結果、第1図(b) に示すように、非熱可塑性樹脂フィルム6同士は含フッ素ポリイミドフィルム3を接着層にして接着し、配線導体2 および7と導通ビアホール8同士は金属粒子4を押しつぶすようにして電気的接続を得ることができ、多層配線基板が完成する。

なお配線フィルム9の製造方法の一例を挙げれば、絶縁性樹脂フィルム6上に、ホトリソグラフ技術を用いて配線導体7を形成する。次に絶縁性樹脂フィルム6をホトエッチングすることによりピアホールパターンを形成し、このピアホールパターン部に電解めっきを用いることにより導通ビアホール8が形成され、配線フィルム9が形成される。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の多層配線基板の 製造方法によれば、耐エッチング性に優れる絶縁 次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され ない

第1図は本発明による多層配線基板の製造方法の一実施例の線略工程図である。第1図において、符号1は基板、2は配線導体、3は含フッ素ポリイミド樹脂、4は金属粒子、5は異方導電性フィルム、6は非熱可塑性樹脂フィルム、7は樹脂フィルム上に形成された配線導体、8は導通ビアホール、9は配線フィルム、10はホットプレートオーブン、11はプレス機を意味する。

第1回(a)に示すように、アルミナなどを主なけるとうまっク、あるの表面に、ホトリソグクスをどからなる基板1の表面になどを主成って技術を用いてCU、AU、Aに配線導体2を設ける。次に配線導体2を設ける。次に配線導体2が形成された基板1との層間に、含フッ素ポリイミルは11にを金属粒子4からなって機器し、プレス機11を配置し、位置合わせをして機器し、プレス機11

性樹脂フィルムにパターン形成を行うので、微細 で 内高精度な配線パターンを樹脂フィルム 成 で おいる に 形成することができ、かつこの配線に縮合された樹脂フィルムを加熱圧着し積層する際に縮合された 発生はなく、 積層界面ではがれ、 いんの膜が りいることもなく、 パターン精度が良好な多層配線 を 仮を容易な プロセスにて形成することができる か 果がある。

また配線導体同士の電気的接続信頼性についても、金属粒子を介して接続しているので、接着界面あるいは配線形成されたフィルム表面の平坦性の影響を受けることもなく、接続信頼性が向上する効果がある。

そのほか熱可塑性樹脂からなる異方尋離性フィルムを用いて接着しているので、再度加熱することにより配線フィルムの剝離が可能であり、リペア性に優れるといった効果もある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による多層配線基板の製造方法

35周平4-177864 (4)

の一実施例の誤略工程図、第2図は従来技術による多層配線基板の製造方法の一例の誤略工程図、第3図は第2図(b) における丸印で囲んだ部分の拡大断面図である。

1 … 基板

2. 7… 配線導体

3…含フッ素ポリイミド樹脂

4 … 金属粒子

5 … 異方導電性フィルム

6…非熱可塑性樹脂フィルム

8 … 導通ビアホール 9,23… 配線フィルム

10…ホットプレートオープン

11…プレス機

21…ポリイミド樹脂

22…銅配線

24…多層フィルム

25…加圧荷重

26…高周波誘電加熱ヒータ

27…銅配線間の拡散接合

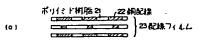
28…ポリイミド樹脂間のイミド化

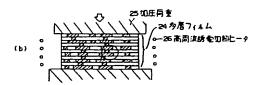
反応による接合

29…多層配線フィルム 30…セラミック基板

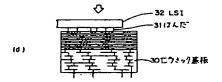
31…はんだ

32... L S I

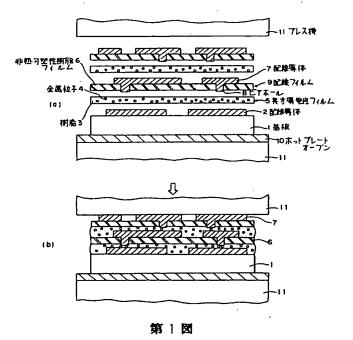








第2図



特開平4-177864 (5)

並教持合27 - 28 イミド化反応による計争合

第3図